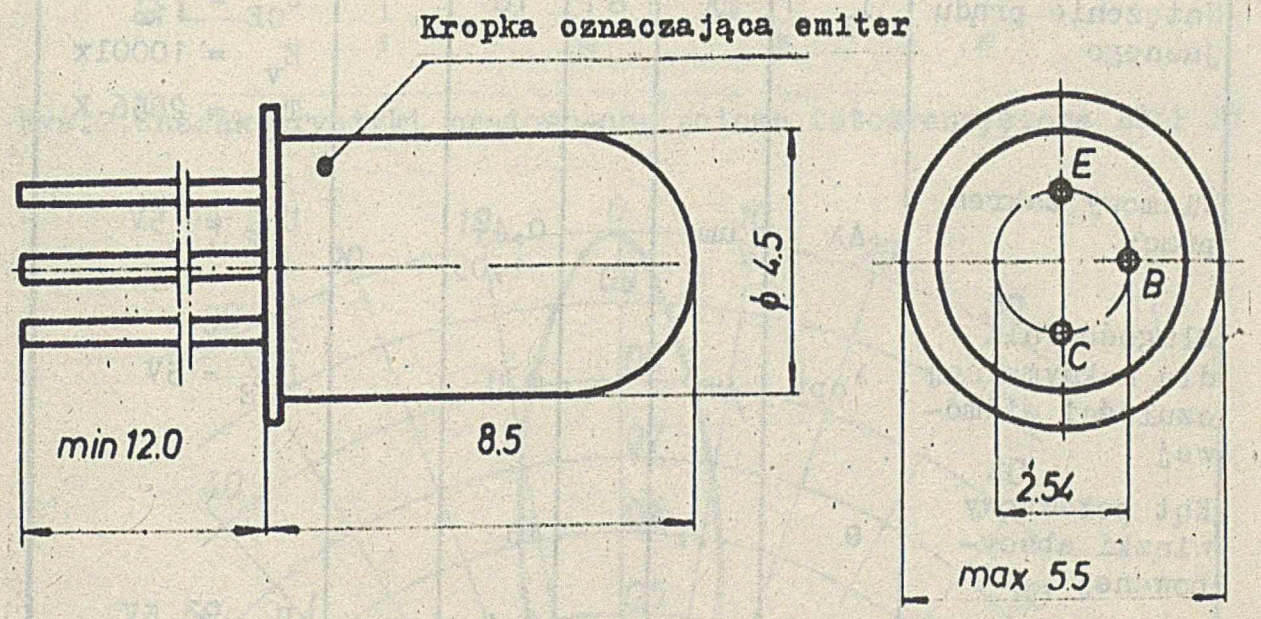
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

FOTOTRANZYSTOR BPXP 27

BPXP 27 jest krzemowym epiplanarnym fototranzystorem n-p-n o bardzo dużej czułości. Posiada wyprowadzaną bazę. Montowany jest w obudowie plastikowej z soczewką. Znajduje zastosowanie w układach automatyki sterowania w przetwornikach analogowo-cyfrowych itp.



Rys.1. Obudowa fotranzystora BPXP 27

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napięcie kolektor-baza	U_{CB} = 70V
Napięcie kolektor-emiter	U_{CE} = 50V
Napięcie emiter-baza	U_{EB} = 7V
Napięcie emiter-kolektor	U_{EC} = 5V

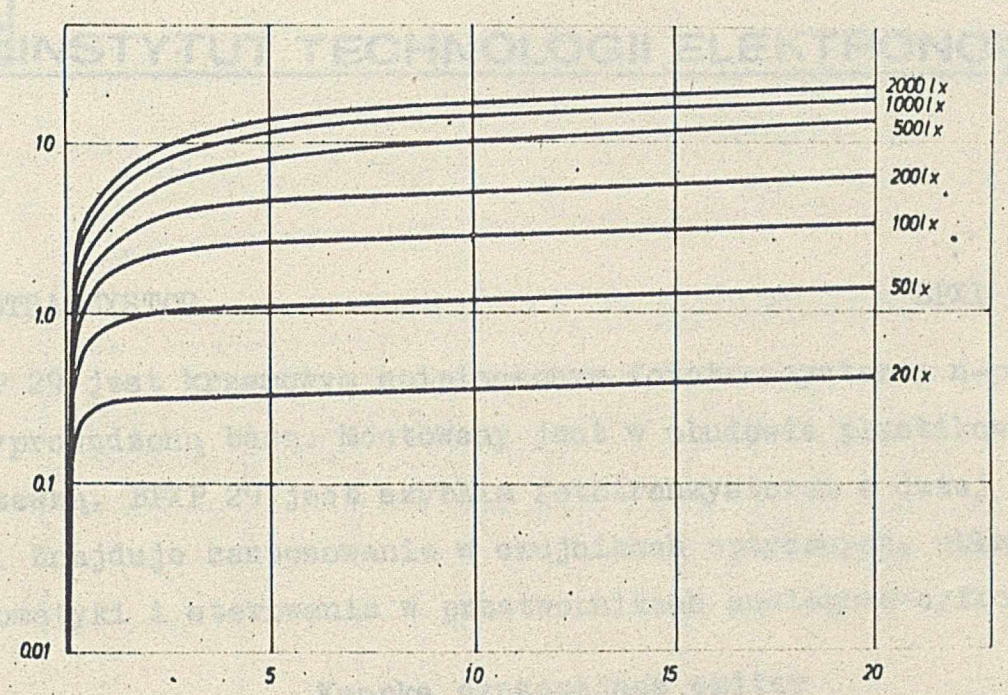
Moc całkowita strat /$t_{amb} \leqslant 45^{o}C$/ P_{tot} = 100 mW

Temperatura złącza t_j = $100^{o}C$

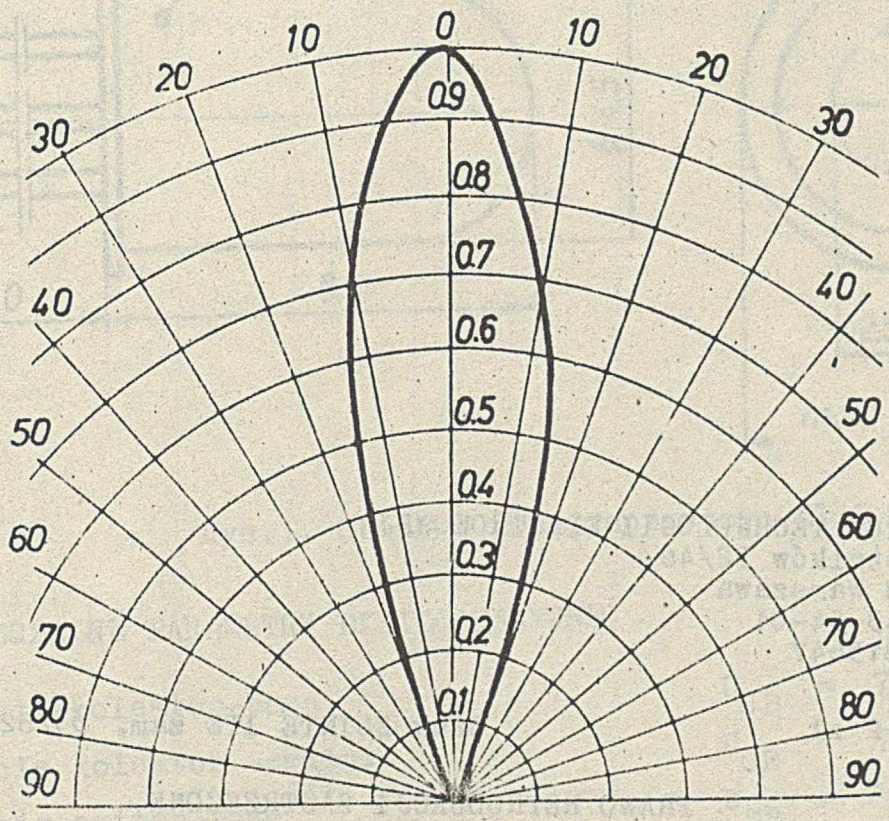
Zakres temperatury otoczenia w czasie pracy t_{amb} = -40° do $+70^{o}C$

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parametru	Symbol	Jedn.	Wartość			Warunki pomiaru
			min	typ	max	
Natężenie prądu ciemnego	I_{CEO}	nA		10	100	U_{CE} = 30V I_B = 0
Natężenie prądu jasnego	I_L	mA	8	10		U_{CE} = 5V E_v = 1000lx T_b = 2856 K
Widmowy zakres pracy	$\Delta\lambda$	µm		0,4÷ 1,05		U_{CE} = 5V
Długość fali dla maksymalnej czułości widmowej	λ_{opt}	µm		0,8		U_{CE} = 5V
Kąt połówkowy wiązki absorbowanej	θ	...°		15		
Czas opóźnienia	t_d	µs		0,4		U_{CE} = 5V I_C = 6 mA I_B = 0 λ = 0,9 µm R_L = 100 Ω
Czas narastania	t_r	µs		2,0	3,5	
Czas magazynowania	t_s	µs		0,2		
Czas opadania	t_f	µs		2,0	3,5	



Rys.2.Charakterystyki prądowo-napięciowe fototranzystora BPXP 27



Rys.3.Charakterystyka kątowa czułości BPXP 27

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
tel. 43-54-01
tlx 815647

Cena 12 zł

Druk ZOINTE ITE zam. 59/82 n.200

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE